покрытиях меньше, чем в исходном образце. При сравнении содержания кислорода в Mo/Al- и W/Al-структурах, полученных в одинаковых условиях, необходимо отметить, что количество кислорода больше в структурах Mo/Al. Установленное различие можно, по-видимому, связать с разной химической активностью Мо и W по отношению к кислороду.

## Список использованных источников

- 1. Структура, термостойкость и микротвердость покрытий  $ZrO_2$ , полученных разными методами / С.Г. Валюхов [и др.] // Неорганические материалы. 2016. Т. 52. № 4. С. 457–463.
- 2. Анализ ядерно-физическими методами состава покрытий, нанесенных на Al осаждением Zr и W при одновременном облучении одноименными ионами / В.В. Тульев [и др.] // Физика и химия обработки материалов. 1998. N = 4. C. 33-36.
- 3. Implantation of titanium, chromium, yttrium, molybdenum, silver, hafnium, tantalum, tungsten and platinum ions generated by a metal vapour vacuum ion source into 440C stainless steel / J. Sasaki [et. al.] // Surf. Coat. Technol. 1992. Vol. 51. P. 166–175.

Чобот А.Н. $^1$ , к.ф.-м.н., Латушко С.И. $^1$ , Желудкевич Д.В. $^1$ , Сиколенко В.В. $^2$ , к.ф.-м.н., Чобот Г.М. $^3$ , к.ф.-м.н., доцент, Латушко Т.В. $^4$ , Карпинский Д.В. $^1$ , к.ф.-м.н.

<sup>1</sup>ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Минск, Республика Беларусь

<sup>2</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

<sup>3</sup>УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», Минск, Республика Беларусь

<sup>4</sup>УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика Беларусь КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ФЕРРИТА ВИСМУТА С ИОНАМИ-ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗА

Одним из условий инновационного развития АПК является использование новых функциональных материалов с улучшенными

физическими свойствами. Благодаря уникальному сочетанию электрических и магнитных свойств материалы, относящиеся к классу мультиферроиков, являются предметом пристального внимания ученых-материаловедов. В этих материалах обнаружено одновременное сосуществование различных типов упорядочения. Как следствие этого, мультиферроики могут одновременно являться ферромагнетиками (либо антиферромагнетиками) и сегнетоэлектриками.

Наиболее известным мультифероиком является феррит висмута. Этот материал обладает высокими температурами перехода в магнитоупорядоченное и сегнетоэлектрическое состояние [1-2]. Однако исходное соединение ВіFeO<sub>3</sub> имеет ряд существенных недостатков: этот состав характеризуется незначительной величиной остаточной намагниченности, обусловленной слабоферромагнитной структурой, а также обладает малой величиной магнитоэлектрического взаимодействия наряду с высокой проводимостью. Не менее известным мультиферроиком является соединение ВіМпО<sub>3</sub>. В отличие от феррита висмута, соединение ВіМпО3 характеризуется низкотемпературным переходом в ферромагнитное состояние (Т<sub>с</sub>~102 К) изменением кристаллической структуры при температуре Т~475 К. При этом кристаллическая структура по-прежнему остается моноклинной. При температуре выше Т~770 К соединение обладает неполярной орторомбической структурой. Магнитная структухарактеризуется положительными BiMnO<sub>3</sub> обменными взаимодействиями между ионами Mn<sup>3+</sup>, характер которых существенно зависит от геометрии химических связей Mn-O-Mn [3]. Замещение ионов  ${\rm Mn}^{3+}$  в соединении  ${\rm BiMnO_3}$  на ионы  ${\rm Fe}^{3+}$  приводит к увеличению температуры перехода в магнитоупорядоченное состояние. При этом усиливается антиферромагнитная компонента в обменных взаимодействиях между ионами Mn<sup>3+</sup> и Fe<sup>3+</sup>. Однако в настоящее время нет четкого понимания механизма изменений, происходящих в магнитной структуре этих составов при химическом замещении марганца ионами переходных металлов.

Соединения  $BiMn_{1-x}Fe_xO_3$  были синтезированы из оксидов  $Bi_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$  и  $Mn_2O_3$ . Составы с x=0.6-0.8 получены на аппарате высокого давления при 5 ГПа и 1300 К. Составы с x=0.1-0.5 получены при перемешивании оксидов в планетарной мельнице с последующим прессованием в таблетки и синтезом при температуре 1000 К в течение 4 часов.

Согласно структурным данным, полученным для образцов  $BiMn_{1-x}Fe_xO_3$  с помощью нейтронного излучения, соединения с концентрацией ионов-заместителей x=0.1-0.3 характеризуются однофазным структурным состоянием (моноклинная фаза, структура типа  $BiMnO_3$  (пространственная группа C2/c)) (рис. 1). Для  $BiMn_{0.80}Fe_{0.20}O_3$  характерна моноклинная элементарная ячейка (a = 9.5379(5); b = 5.6167(3); c = 9.7400(5) и  $\beta$  = 108.460(3)).

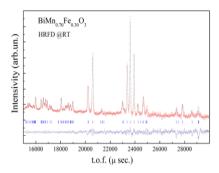


Рисунок 1 — Нейтронограмма соединения BiMn<sub>0.70</sub>Fe<sub>0.30</sub>O<sub>3</sub>

В структуре составов  $BiMn_{1-x}Fe_xO_3$  с x=0.4-0.5 преобладает орторомбическая фаза с характерным антиполярным смещением ионов висмута и марганца (пространственная группа Pnma), а также присутствует незначительная (~ 10–15 %) часть моноклинной фазы. Соединения  $BiMn_{1-x}Fe_xO_3$  с x=0.6–0.8 характеризуются однофазной орторомбической структурой (пространственная группа Pnma) с орторомбической элементарной ячейкой а = 5.6072(3); b = 15.6173(9); c = 11.2444(7) (рис. 2). Эта структура является метастабильной.

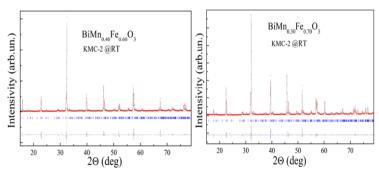


Рисунок 2 — Дифрактограммы соединений  $BiMn_{0.40}Fe_{0.60}O_3$  и  $BiMn_{0.30}Fe_{0.40}O_3$ 

Таким образом, нами установлено, что соединения  $BiFeO_3$  и  $BiMnO_3$  образуют твердые растворы во всем диапазоне составов. Новая орторомбическая ( $\sqrt{2}a_p \times 4a_p \times 2\sqrt{2}a_p$ ) фаза обнаружена между ромбоэдрическим  $BiFeO_3$  и моноклинным  $BiMnO_3$ .

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант №Т20Р-121) и РФФИ (грант № 20-52-00023).

## Список использованных источников

- 1. Слабый ферромагнетизм в мультиферроиках на основе  $BiFeO_3$  / И.О. Троянчук [и др.] // Письма в ЖЭТФ. 2009. Т. 89, №4. С. 204–208.
- 2. Фазовые превращения в мультиферроиках  $Bi_{1-x}Ca_xFe_{1-x}Mn_xO_3$  / И.О. Троянчук [и др.] // ФТТ. 2016. Т. 58, №9. С. 1719—1723.
- 3. Crystal and Magnetic Structure Transitions in BiMnO $_{3+\delta}$  Ceramics Driven by Cation Vacancies and Temperature / D.V. Karpinsky [et al.] // Materials. -2021.-V. 14. -P. 5805.

## Шевченок А.А., к.т.н., доцент Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Республика Беларусь СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ SR ВІ₂ТА₂О₀ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

Тонкие сегнетоэлектрические пленки находят применение при создании устройств энергонезависимой памяти, конденсаторов, микроактюаторов, приемников инфракрасного излучения, оптических процессоров, волноводов и линий задержки, приборов на поверхностных акустических волнах и других акустооптических устройств. Однако практическое использование сегнетоэлектрических пленок в микроэлектронике сталкивается с серьезными трудностями из-за отсутствия совместимой технологии получения тонкопленочных сегнетоэлектрических материалов высокого качества с воспроизводимыми свойствами. И лишь в последнее десятилетие удалось добиться контролируемой совместимости тонких слоев сегнетоэлектриков с полупроводниковыми коммутационными мат-